

低入力駆動フォトカプラの 基本特性と応用設計

概要

本資料はフォトカプラのラインアップの中でも低入力(低 I_F)駆動が可能な製品群の応用設計をする中で電気的特性の特徴および性能を最大限引き出す留意点について述べたものです。

2019-05-17



目次

1.	選定	ミするフォトカプラの候補	3
1.	1	低 I _F 駆動製品群の種類	3
2.	トラン	ンジスタカプラを使ったインタフェース回路の設計	5
2.	1	順電流 I _F の設定	7
2.	2	I _F 制限抵抗 R _{IN} の設定	8
2.	3	プルアップ抵抗 R _L の設定	12
2.		設定された上記プルアップ抵抗 R」で期待できる伝搬遅延時間	
2.		低 I _F 駆動製品で性能を最大限引き出す留意点	
3.	用語	語説明	24
制厂	田のりま	切い上のお願い	27



1. 選定するフォトカプラの候補

フォトカプラは、一般に発光素子と受光素子との間に光透過性の絶縁物を介して光学的に結合し、接地電位の異なる回路間の信号インタフェースとして使用されるデバイスです。インピーダンスの不整合解消、入出力間の絶縁能力の向上、誘導起電力の回避、ノイズしゃ断の容易性などのメリットからフォトカプラが使用されてきていますが、さらに基板占有面積の縮小化、信頼性向上によるメンテナンスフリーなどのメリットによりフォトカプラの応用が拡大しています。

産業用電子機器などのシステム設計を行う場合、伝送ライン上に介在する種々の問題に悩まされることがあります。例えば、グランドループによるオフセット電圧が発生したときには、システム間にループ電流が流れ機器を破損する可能性も起こります。これらの問題に関して短距離用としてはフォトカプラを用いることが有効な対処法です。

電子機器においては省電力化は大きな流れの一つですが、その中でデータ信号伝送用として使用されている汎用トランジスタカプラでも省電力制御の流れを実現するために低入力(低 I_F 駆動)製品群の商品化が強く求められており、当社ではこのような市場ニーズに応えるため積極的に各種ラインナップを進めております。

これらの製品を適用する上ではその性能を最大限引き出すにはいくつかの留意点があります。本資料ではこれら低 I_F 駆動製品群の種類と特性および応用設計について述べます。

1.1 低 I 駆動製品群の種類

図 1.1 に代表的な 3 つの製品を示します。小型・薄型 SO6 パッケージで汎用のトランジスタカプラ TLP185 と、それに対して低入力(低 I_F 駆動)の TLP183, およびさらにそれの高速対応版の TLP2301 です。

項目	製品名	TLP185(SE	TLP183	TLP2301
出力	タイプ	シングルTr (汎用)	シングルTr (低入力)	シングルTr (低入力,高速)
内部挂	妾続図	**		
パック	ケージ	S.	4pin SO6	
→ 1/2 → 1. → -	ランク無	50~600%	50~600%	50~600%
変換効率 (CTR)	GBランク	100~600%	100~600%	100~600%
Ic/If	条件	@I _F =5mA,V _{CE} =5V	@I _F =0.5mA,V _{CE} =5V	@I _F =1mA,V _{CE} =5V
遅延時間	間[toff]	40μs (typ.) @ I _F =16mA , R _L =1.9kΩ	30μs (typ.) @ I _F =1.6mA , R _L =4.7kΩ	t_{pLH} (max.) =30μs @ $I_F=1$ mA , $R_L=10$ kΩ
Vo	CEO CEO	80V(min)	80V(min)	40V(min)
動作温	度 Topr	-55~110℃	-55~125℃	-55~125℃
絶縁耐	王 BV s		3750Vrms	

図 1.1 代表的な製品 TLP185、TLP183、TLP2301 の概要

変換効率(CTR)は入力側 LED に流す電流 I_F に対する出力側トランジスタのコレクタ電流 I_C の比率 (I_C/I_F) を%で表したものとして定義します。CTR は、 I_F 条件によって変わりますが、標準条件は I_F =5mA、 V_{CE} =5V、低入力(低 I_F 駆動)型では I_F =1mA や I_F =0.5mA で設定しています。



低 I_F駆動製品群

TLP185 @ I_F =5mA CTR=50%-600% TLP183 @ I_F =0.5mA CTR=50%-600% TLP2301 @ I_F =1mA CTR=50%-600%

また汎用型の TLP185 と低入力(低 I_F 駆動)型の TLP183 で CTR の I_F 依存性をみてみると図 1.2 で見られるように違った性能が得られます。

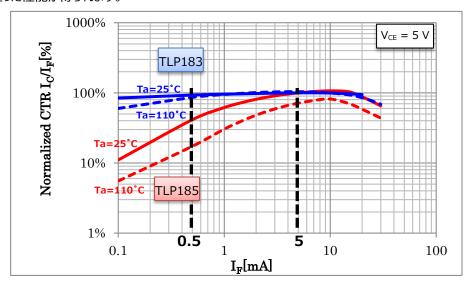


図 1.2 代表的な製品 TLP185、TLP183 における CTR の IF 依存性

図 1.2 で確認できるように I_F の小さい領域で違いが顕著で、 I_F =0.5mA \sim 5mA の間でみると

 $@I_{\text{F}}\text{=}5\text{mA} \,\rightarrow\, I_{\text{F}}\text{=}0.5\text{mA}$

TLP185 CTR の変化≒約 1/2 に低下 TLP183 CTR の変化≒約数%の低下

となっており、TLP183 タイプでは CTR の低減が非常に押さえられています。これは高出力、長寿命の新しい世代の発光素子(LED)を採用したことに起因します。TLP2301 も同様です。この挙動が低入力(低 I_F 駆動)型の製品実現や商品性能に大きく貢献しています。



2. トランジスタカプラを使ったインタフェース回路の設計

図 2.1 はロジック IC 間インタフェースに 4 ピンのフォトカプラを使った回路です。 確実な ON/OFF 信号伝送動作を得るための R_{IN} と R_L の設計を行います。入力電流 I_F を仮設定し、出力トランジスタの飽和電圧時に得られるコレクタ電流の最小値を求めてプルアップ抵抗 R_L を決定します。

設計仕様例

動作温度 T_{opr} : 0~70°C データ速度 : 5 kbps

電源電圧 : V_{CC} = 5 V ± 5% 動作寿命 : 10 年 (8.8 万時間)

システム稼動率:50%

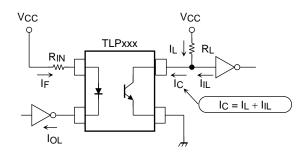


図 2.1 4 ピンのフォトカプラを使った TTL 間インタフェース回路

まずフォトカプラの選定を行います。

今回は一般品の TLP185(SE、低入力品の TLP183 とその IC タイプの TLP2301 で設計を試みます。 設計に必要な規格を表 2.1 に示します。



耒 2 1 /	(1)	フォトカプラ TLP185(SE	の主亜特性
衣乙」((I)	711777 LL102(2E	の土安付注

	項	目		記号	測定条件(Ta = 25°C)	最小値	標準値	最大値	単位
入	カ	順	電 圧	V _F	$I_F = 10 \text{ mA}$		1.1	1.25	1.4	V
コレ	クタ・エミ	ッタ間隆	子伏 電圧	V (BR) CEO	$I_C = 0.5 \text{ mA}$		80		_	V
ΙΞ	ッタ・コレク	クタ間降	子伏 電圧	V (BR) ECO	$I_{E} = 0.1 \; mA$		7		_	V
暗		電	流	Inany	$I_F = 0 \text{ mA, } V_{CE} =$	= 48 V		0.01	0.08	μΑ
РН		电	<i>/</i> /IL	I _{DARK}	$I_F = 0 \text{ mA, } V_{CE} =$	= 48 V, Ta = 85°C		2	50	μΑ
					I _F = 5 mA	一般品	50		600	
変	換	効	率	CTR (I _C /I _F)	$V_{CF} = 5 \text{ V}$	GB ランク	100		600	%
					VCE - 5 V	GR ランク	100		300	
コレ	クタ・エミ	ッタ間飲	10 和電圧	V _{CE} (sat)	$I_F = 8 \text{ mA}, I_C = 3$	2.4 mA			0.3	V

表 2.1 (2) フォトカプラ TLP183 の主要特性

	Į	頁 目			記号	測定条件((Ta = 25°C)	最小値	標準値	最大値	単位
入	カ	順	電	圧	V_{F}	$I_F = 10 \text{ mA}$		1.1	1.25	1.4	V
コレ	クタ・エ	ミッタ間	降伏	電圧	V (BR) CEO	$I_C = 0.5 \text{ mA}$		80		_	V
ΙΞY	ッタ・コし	ノクタ間	降伏	電圧	V (BR) ECO	$I_{E} = 0.1 \; mA$		7			V
暗		電		流	Inany	$I_F = 0 \text{ mA, } V_{CE} =$	= 48 V		0.01	0.08	μΑ
ΡΗ		电		// IL	I _{DARK}	$I_F = 0 \text{ mA, } V_{CE} =$	= 48 V, Ta = 85°C		2	50	μΑ
						$I_F = 0.5 \text{ mA}$	一般品	50		600	
変	換	3	効	率	CTR (I_C/I_F)	$V_{CF} = 5 \text{ V}$	GB ランク	100		600	%
						VCE - 3 V	GR ランク	100		300	
コレ	クタ・エ	ミッタ間	飽和	電圧	V _{CE} (sat)	I_F = 8 mA, I_C =	2.4 mA	_	_	0.3	V

表 2.1 (3) フォトカプラ TLP2301 の主要特性

	項	i 🗏			記号	測定条件(Ta = 25°C)	最小値	標準値	最大値	単位
入	カ	順	電	圧	V _F	$I_F = 10 \text{ mA}$		1.1	1.25	1.4	V
コレ	クタ・エミ	ミッタ間	降 伏	電圧	V (BR) CEO	$I_C = 0.1 \text{ mA}$		40		_	V
ΙΞ'n	ッタ・コレ	クタ間	降 伏	電圧	V (BR) ECO	$I_{E} = 0.1 \; mA$		7			V
暗		電		流	T= . =	$I_F = 0 \text{ mA, } V_{CE} =$	= 40 V		0.01	0.08	μΑ
ч		电		<i>/</i> /IL	I _{DARK}	$I_F = 0 \text{ mA, } V_{CE} =$	= 40 V, Ta = 85°C		2	50	μΑ
変	換	ź	动	率	CTR (I _C /I _F)	$I_F = 1 \text{ mA}$	一般品	50		600	%
Ø.	政	,	אי		CIK (1() 1F)	$V_{CE} = 5 V$	GB ランク	100		600	70
コレ	クタ・エミ	ミッタ間	飽和	電圧	V _{CE (sat)}	$I_F = 8 \text{ mA}, I_C = 3$	2.4 mA		_	0.3	V

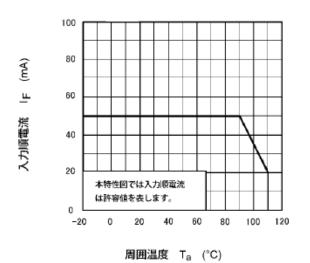


2.1 順電流 IF の設定

まず初めに LED 駆動電流 I_Fを仮設定します。

(1)TLP185 の場合

 I_F の最大は入力側ロジック IC の出力ローレベル吸い込み電流最大値 I_{OL} かりも小さくなければなりません。標準的なロジック IC I_{OL} を 8mA とすると $I_F \le I_{OL}$ から、 $I_F \le 8$ mA となります。また I_F の最大許容値は図 2.2 から $I_F \le 5$ 0mA ですが、変換効率 CTR の経年変化が I_F の増大により大きくなりますので、必要最小限にします。図 2.3 は TLP185(SE に適用している LED の光出力の経年変化例を示すものですが、今回は 10 年(約 8.8 万時間,稼働率 50%で 4.4 万時間)の動作寿命を期待するため CTR の低下分は約 30%($D_t = 0.7$)と考えてみます。 CTR が $I_F = 5$ mA で規定されていることを意識しこれを取り入れ $I_F = 5$ mA $I_F = 5$ mA から I_{OL} 値の 8mA に仮設定します。



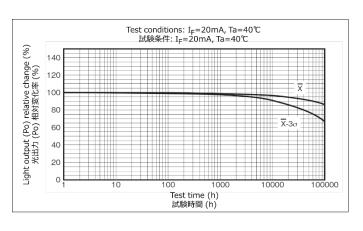


図 2.2 許容順電流-周囲温度 (TLP185(SE)

図 2.3 推定経年変化データ例(*)

*本データは CTR 経年劣化カーブの一例を示しております。TLP185(SE を含めた各製品の実際の回路設計の際には個別製品の信頼性情報をご確認の上適切な設計をお願い致します。

(2)TLP183 の場合

TLP183 は I_F =5mA の他に I_F =0.5mA の低電流条件で変換効率や伝搬遅延時間を規定しています。図 2.4 は TLP183,TLP2301 で適用している LED の光出力の経年変化例を示すものです。変換効率 CTR の経年変化 は I_F が小さい方が有利ですが、今回は 10 年(約 8.8 万時間,稼働率 50%で 4.4 万時間)の動作寿命を期待する こともあり CTR の低下分は約 15%(D_t =0.85)と考えてみます。CTR の規定条件を意識し I_F =0.5mA で計算し てみると I_F =0.5mA / 0.85=0.6mA となりますが、ここでは余裕分も踏まえて 1mA に仮設定してみます。

(3)TLP2301 の場合

TLP2301 は $I_F=1$ mA の低電流条件で変換効率や伝搬遅延時間を規定しています。CTR の低下分は前出の TLP183 と同様約 15%は考慮が必要ですが、一方大きな電流を流すと伝搬遅延時間が遅くなるなどの影響もでて きます。TLP2301 は高速対応版でかつ $I_F=1$ mA 条件で伝搬遅延時間を規定していますのでこれに近い条件で電流設定を行うと有利です。2つの相反する要因も加味し今回はワースト条件でも $I_F=1$ mA が流れるように仮設定を して設計を行ってみます。



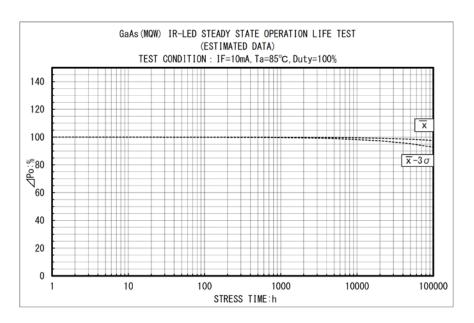


図 2.4 推定経年変化データ例(*)

*本データは CTR 経年劣化カーブの一例を示しております。TLP183,TLP2301 を含めた各製品の実際の回路設計の際には個別製品の信頼性情報をご確認の上適切な設計をお願い致します。

2.2 I_F制限抵抗 R_{IN}の設定

 $I_{F(typ.)}$ は、

$$I_{F(typ.)} = \frac{v_{\text{CC}} - v_{F(typ.)} - v_{\text{OL}}}{R_{\text{IN}(typ.)}}$$

で示されます。

(1)TLP185 の場合

$$V_{F (typ.)}$$
はデータシート値(図 2.5)から、
$$V_{F (typ.)} = 1.25 \ V \ (I_F = 10 mA)$$

ですので、これを用いて

$$R_{IN} = \frac{5V - 1.25V - 0.4V}{8mA}$$
$$= 419 \Omega$$

よってここでは $R_{IN}=430~\Omega\pm5\%$ を選択します。

 $I_{F(min)}$ 、 $I_{F(max)}$ 値を確認すると、下記のようになります。

 V_{CC} は $5V\pm5\%$ 、 V_F はデータシート値から

 $V_{CC (min)} = 5V - 5\% = 4.75V, V_{CC (max)} = 5V + 5\% = 5.25V$

$$V_{F (min)} = 1.1 V, V_{F (max)} = 1.4 V$$

(Ta=25°C)

	項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
発光側	入力順電圧	V _F		I _F = 10 mA	1.1	1.25	1.4	V

図 2.5 TLP185(SE データシートの抜粋



$$\begin{split} I_{F(min.)} &= \frac{v_{CC(min.)} - v_{F(max.)} - v_{OL}}{R_{IN(max.)}} \\ &= \frac{4.75V - 1.4V - 0.4V}{452\Omega} \\ &= 6.5 \text{ mA} \\ \\ I_{F(max.)} &= \frac{v_{CC(max.)} - v_{F(min.)} - v_{OL}}{R_{IN(min.)}} \\ &= \frac{5.25V - 1.1V - 0.4V}{409\Omega} \end{split}$$

となります。

(2)TLP183 の場合

V_{F (typ.)}はデータシート値(図 2.6)では、

$$V_{F (typ.)} = 1.25 \text{ V } (I_F = 10 \text{mA})$$

= 9.2 mA

ですが、この値を基準に $I_F = 1$ mA の条件での値を見積ります。

図 2.7 から、この時は約 0.1V 下がります。

(Ta=25℃)

	項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
発光側	入力順電圧	V _F		I _F = 10 mA	1.1	1.25	1.4	٧

図 2.6 TLP183 データシートの抜粋

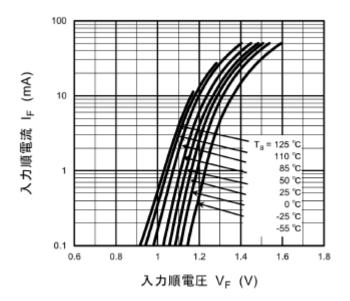


図 2.7 TLP183 データシートの抜粋 $I_F - V_F \ \mbox{特性}$



$$R_{IN} = \frac{5V - 1.15V - 0.4V}{1mA}$$
$$= 3.45 \text{ k}\Omega$$

よってここでは $R_{IN}=3.3~k\Omega\pm5\%$ を選択します。

 $I_{F(min)}$ 、 $I_{F(max)}$ 値を確認すると、下記のようになります。

 V_{CC} は $5V\pm5\%$ 、 V_F はデータシート値とデータシートの I_F - V_F 特性グラフ(図 2.7)から

 $V_{CC (min)} = 5V - 5\% = 4.75V, V_{CC (max)} = 5V + 5\% = 5.25V$

 $V_{F (min)} = 1.0 V, V_{F (max)} = 1.3 V$

$$\begin{split} I_{F(min.)} &= \frac{v_{CC(min.)} - v_{F(max.)} - v_{OL}}{R_{IN(max.)}} \\ &= \frac{4.75V - 1.3V - 0.4V}{3.47k\Omega} \\ &= 0.88 \text{ mA} \end{split}$$

$$\begin{split} I_{F(max.)} &= \frac{v_{CC(max.)} - v_{F(min.)} - v_{OL}}{R_{IN(min.)}} \\ &= \frac{5.25V - 1.0V - 0.4V}{3.14k\Omega} \\ &= 1.23 \text{ mA} \end{split}$$

となります。

(3)TLP2301 の場合

V_{F (typ.)}はデータシート値(図 2.8)では、

$$V_{F (typ.)} = 1.25 \text{ V } (I_F = 10 \text{ mA})$$

ですが、この値を基準に $I_F = 1$ mA の条件での値を見積ります。

図 2.9 から、この時は約 0.1V 下がります。

(Ta=25℃)

							,	
	項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
発光側	入力順電圧	V _F		I _F = 10 mA	1.1	1.25	1.4	V

図 2.8 TLP2301 データシートの抜粋



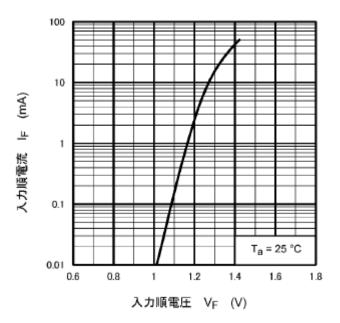


図 2.9 TLP2301 データシートの抜粋 $I_F - V_F$ 特性

$$R_{IN} = \frac{5V - 1.15V - 0.4V}{1mA}$$
$$= 3.45 \text{ k}\Omega$$

よってここでは $R_{IN}=3.3~k\Omega\pm5\%$ を選択します。

 $I_{F(min)}$ 、 $I_{F(max)}$ 値を確認すると、下記のようになります。

 V_{CC} は $5V\pm5\%$ 、 V_F はデータシート値とデータシートの I_F - V_F 特性グラフ(図 2.9)から

$$V_{CC (min)} = 5V - 5\% = 4.75V, V_{CC (max)} = 5V + 5\% = 5.25V$$

$$V_{F (min)} = 1.0 V, V_{F (max)} = 1.3 V$$

$$\begin{split} I_{F(min.)} &= \frac{v_{CC(min.)} - v_{F(max.)} - v_{OL}}{R_{IN(max.)}} \\ &= \frac{4.75V - 1.3V - 0.4V}{3.47k\Omega} \\ &= 0.88 \text{ mA} \end{split}$$

$$\begin{split} I_{F(max.)} &= \frac{v_{CC(max.)} - v_{F(min.)} - v_{OL}}{R_{IN(min.)}} \\ &= \frac{5.25V - 1.0V - 0.4V}{3.14k\Omega} \\ &= 1.23 \text{ mA} \end{split}$$

となります。



2.3 プルアップ抵抗 RL の設定

プルアップ抵抗 R_L はワーストケースの I_C を超えない範囲で設定をします。 ワーストケースの I_C 値を $minI_C$ とすると、

$$R_L \, \geq \, \frac{V_{\text{CC(max.)}} - V_{\text{IL}}}{\text{minI}_{\text{C}}}$$

 $minI_C = I_{C (min)} \times D_t \times D_{IF} \times D_{VCE} \times D_{Ta} \times \alpha$

で表すことができます。ここで、

V_{IL}:後段素子のローレベル入力電圧の最大値(または必要なローレベル出力電圧)

D_t:ある時間経過後の I_C低下率

 D_{IF} :データシート条件に対する I_F 設定値での I_C 変化率

 $D_{VCE}:V_{CE\,(sat)}$ 状態での I_{C} 低下率 $D_{Ta}:$ 動作温度内での I_{C} 変動率

a :設計マージン

として、これらの値をデータシート等から確認します。

(1)TLP185 の場合

 $I_{C(min)}$: 今回は TLP185(SE の GB ランクを選択します。 GB ランクは I_F =5mA, V_{CE} =5V の条件で変換効率の最小値が 100%なので、今回は $I_{C(min)}$ =5mA x 100%=5mA となります。

 D_t : 時間経過後の I_c の低下は LED の光出力の低下に強く依存します。図 2.10 は TLP185(SE に適用している LED の光出力の経年変化例を示すものですが、今回はこのカーブから 4.4 万時間 (期待寿命 10 年、約 8.8 万時間 の稼働率 50%)の光出力を算出するとおよそ 80%です。 I_c の低下率としては若干のマージンを考慮し 70%として D_t =0.7 とします。

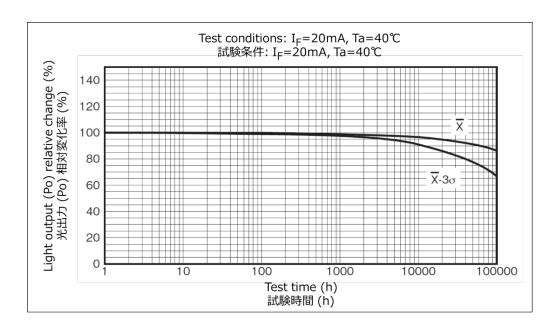


図 2.10 推定経年変化データ例(*)

*本データは LED 光出力劣化カーブの例であり TLP185(SE のデータそのものではありません。TLP185 を含めた各製品の実際の回路設計の際には個別製品の信頼性情報をご確認の上適切な設計をお願い致します。



 D_{IF} : データシート条件に対する I_F 設定値での I_C 変化率は TLP185(SE の I_C - I_F カーブから求めます。今回は I_F =8mA 条件ですので、図 2.11 のカーブから、 I_C (@ I_F =5mA)=9.5mA, I_C (@ I_F =8mA)=16mA を読み取り、変 化率を計算すると D_{IF} =16mA / 9.5mA \doteqdot 1.7 となります。

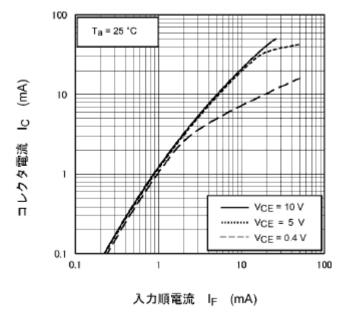


図 2.11 TLP185(SE データシートの抜粋 $I_C - I_F$ 特性

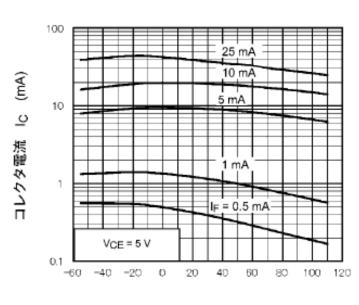


図 2.12 TLP185(SE データシートの抜粋 I_C - Ta 特性

周囲温度 T_a (°C)

 D_{VCE} : $V_{CE(sat)}$ (\doteqdot 0.4V)状態での I_C 低下率は図 2.11 のカーブから求めます。 $I_F=8$ mA の時, I_C (@ $V_{CE}=5$ V)=16mA, I_C (@ $V_{CE}=0.4$ V)=6.5mAを読み取り、変化率を計算すると $D_{VCE}=6.5$ mA / 16mA \doteqdot 0.4となります。

 D_{Ta} : T_{opr} 内での I_C 変動率は図 2.12 I_C - Ta カーブから求めます。 I_F =8mA に近い I_F =10mA のカーブを利用すると、 I_C が小さくなるのは 70 $^\circ$ C の時なので、 I_C (@Ta=25 $^\circ$ C)=20mA, I_C (@Ta=70 $^\circ$ C)=16mA を読み取り、変化率を計算すると D_{Ta} =16mA / 20mA \div 0.8 となります。

a: 設計マージンは今回 20%とし a=0.8 とします。

よってこれらを計算すると

$$minI_{C} = I_{C \; (min)} \times D_{t} \times D_{IF} \times D_{VCE} \times D_{Ta} \times \alpha$$

$$minI_C = 5mA \times 0.7 \times 1.7 \times 0.4 \times 0.8 \times 0.8$$

 $minI_C = 1.5 mA$

$$R_L \geq \frac{v_{\text{CC(max.)}} - v_{\text{IL}}}{\min I_{\text{C}}}$$

$$R_{L} \ge \frac{5.25V - 0.6V}{1.5mA}$$

$$R_L \ge 3.1 k\Omega$$

 R_L を大きくするとマージンが上がりますが、大きすぎると伝搬遅延時間 t_{OFF} が遅くなりますので今回は 1.5 倍ほどの 4.7 $k\Omega$ を選択します。



(2)TLP183 の場合

 $I_{C(min)}$: 今回は TLP183 の GB ランクを選択します。 GB ランクは I_F =0.5mA, V_{CE} =5V の条件で変換効率の最小値が 100%なので、今回は $I_{C(min)}$ =0.5mA x 100%=0.5mA となります。

 D_t : 時間経過後の I_c の低下は LED の光出力の低下に強く依存します。図 2.13 は TLP183,TLP2301 に適用している LED の光出力の経年変化例を示すものですが、今回はこのカーブから 4.4 万時間 (期待寿命 10 年、約 8.8 万時間の稼働率 50%)の光出力を算出するとおよそ 90%です。 I_c の低下率としては若干のマージンを考慮し 85%として D_t =0.85 とします。

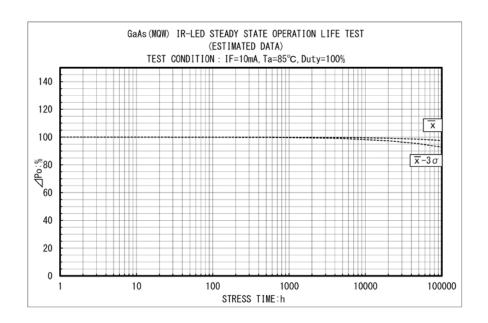


図 2.13 推定経年変化データ例(*)

*本データは LED 光出力劣化カーブの例であり TLP183,TLP2301 のデータそのものではありません。TLP183,TLP2301 を含めた各製品の実際の回路設計の際には個別製品の信頼性情報をご確認の上適切な設計をお願い致します。

 D_{IF} : データシート条件に対する I_F 設定値での I_C 変化率は TLP183 の I_C - I_F カーブから求めます。 今回は I_F =1mA 条件ですので、図 2.14 のカーブから、 I_C (@ I_F =0.5mA)=0.95mA, I_C (@ I_F =1mA)=2mA を読み取り、変化率を計算すると D_{IF} =2mA / 0.95mA \doteqdot 2.1 となります。



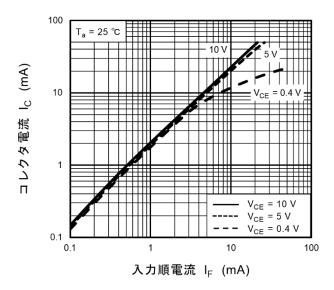


図 2.14 TLP183 データシートの抜粋 $I_C - I_F$ 特性

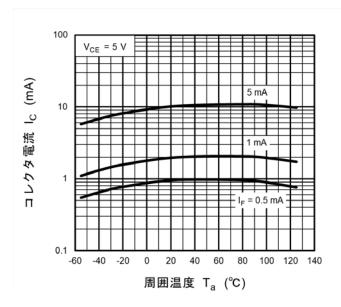


図 2.15 TLP183 データシートの抜粋 I_C - Ta 特性

 D_{VCE} : $V_{CE\ (sat)}\ (=0.4V)$ 状態での I_C 低下率は図 2.14 のカーブから求めます。 $I_F=1$ mA の時, I_C (@ $V_{CE}=5$ V)=2mA, I_C (@ $V_{CE}=0.4V$)=1.9mA を読み取り、変化率を計算すると $D_{VCE}=1.9$ mA / 2mA=0.95 となります。

 D_{Ta} : T_{opr} 内での I_C 変動率は図 2.15 I_C - Ta カーブから求めます。 I_F =1mA のカーブを利用すると、 I_C が小さくなるのは 0°C の時なので、 I_C (@Ta=25°C)=2mA, I_C (@Ta=0°C)=1.8mA を読み取り、変化率を計算すると D_{Ta} =1.8mA / 2mA \doteqdot 0.9

a:設計マージンは今回 20%とし a=0.8 とします。

よってこれらを計算すると

 $minI_{C} = I_{C (min)} \times D_{t} \times D_{IF} \times D_{VCE} \times D_{Ta} \times \alpha$

 $minI_C = 0.5mA \times 0.85 \times 2.1 \times 0.95 \times 0.9 \times 0.8$

 $minI_C = 0.61 \text{ mA}$

 $R_L \geq \frac{v_{\text{CC(max.)}} - v_{\text{IL}}}{\min I_{\text{C}}}$

 $\mathrm{R_L} \geq \frac{5.25\mathrm{V} - 0.6\mathrm{V}}{0.61\mathrm{mA}}$

 $R_L \ge 7.6 k\Omega$

 R_L を大きくするとマージンが上がりますが、大きすぎると伝搬遅延時間 t_{OFF} が遅くなりますので今回は $10k\Omega$ を選択します。



(3)TLP2301 の場合

 $I_{C(min)}$: 今回は TLP2301 の GB ランクを選択します。 GB ランクは I_F =1mA, V_{CE} =5V の条件で変換効率の最小値が 100%なので、今回は $I_{C(min)}$ =1mA x 100%=1mA となります。

 D_t : 時間経過後の I_C の低下は LED の光出力の低下に強く依存します。前項の図 2.13 は TLP2301 に適用している LED の光出力の経年変化例も示すものですが、今回はこのカーブから 4.4 万時間 (期待寿命 10 年、約 8.8 万時間の稼働率 50%)の光出力を算出するとおよそ 90%です。 I_C の低下率としては若干のマージンを考慮し 85%として D_t =0.85 とします。

 D_{IF} : データシート条件に対する I_F 設定値での I_C 変化率はTLP2301の I_C - I_F カーブから求めます。今回は I_F =1mA 条件ですので D_{IF} =1 です。もし I_F =3mA の場合だと、図 2.16 のカーブから、 I_C (@ I_F =1mA)=1.8mA, I_C (@ I_F =3mA)=6.2mA を読み取り、変化率を計算すると D_{IF} =6.2mA / 1.8mA \rightleftharpoons 3.4 となります。

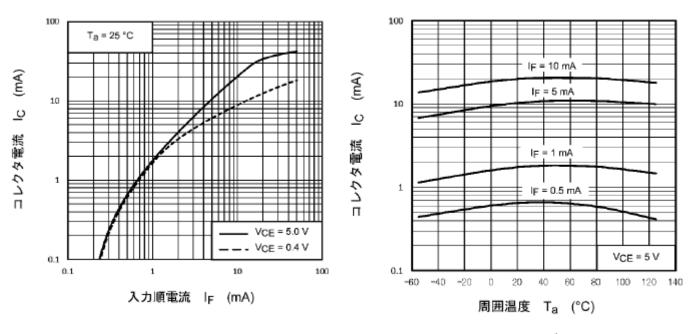


図 2.16 TLP2301 データシートの抜粋 $I_C - I_F$ 特性

図 2.17 TLP2301 データシートの抜粋 I_C - Ta 特性

 D_{Ta} : T_{opr} 内での I_C 変動率は図 2.17 I_C - Ta カーブから求めます。 $I_F=1$ mA のカーブを利用すると、 I_C が小さくなるのは 0° C の時なので、 I_C (@ $Ta=25^{\circ}$ C)=1.8mA, I_C (@ $Ta=0^{\circ}$ C)=1.6mA を読み取り、変化率を計算すると $D_{Ta}=1.6$ mA / 1.8mA \doteqdot 0.88

a:設計マージンは今回 20%とし a=0.8 とします。



よってこれらを計算すると

$$minI_{C} = I_{C \, (min)} \times D_{t} \times D_{IF} \times D_{VCE} \times D_{Ta} \times \alpha$$

$$minI_C = 1mA \times 0.9 \times 1 \times 0.95 \times 0.88 \times 0.8$$

 $minI_C = 0.6 mA$

$$R_L \geq \frac{v_{\text{CC}(\text{max.})} - v_{\text{IL}}}{\text{minI}_{\text{C}}}$$

$$R_L \ge \frac{5.25V - 0.6V}{0.6mA}$$

$$R_L \ge 7.8 k\Omega$$

 R_L を大きくするとマージンが上がりますが、大きすぎると伝搬遅延時間 t_{pLH} が遅くなりますので今回は $10k\Omega$ を選択します。

2.4 設定された上記プルアップ抵抗 RL で期待できる伝搬遅延時間

5 kbit/s の信号伝送を実現したい場合、スイッチング時間の合計は、

$$T = t_{ON} + t_{OFF} \le 200 \mu s$$

を満たす必要があります。

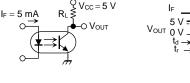
スイッチング時間は CTR(変換効率)や R_L (負荷抵抗)や Ta(周囲温度)など様々な条件により変化します。

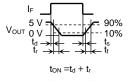
まず、スイッチング時間と CTR の関係を確認します。図 2.18 に示すデータを確認すると、CTR が高くなると toff (=ts+tf)が遅くなる傾向があることが分かります。これは CTR が大きい製品ではフォトトランジスタの hfeが高い傾向があるからです。スイッチング時間の制限がある場合には小さい CTR ランクの製品を使用したほうが有利です。また、スイッチング時間は製品によるばらつきがあり、例えばこの製品の場合でも同じ CTR = 200%程度であっても製品によって toffに 10 μs 程度の差があることがグラフから分かります。このような製品のばらつきや他の Ta, RL 等による変動分も考慮しておく必要があります。

(1)TLP185 の場合

図 2.20 の R_L 依存性グラフから R_L =4.7 $k\Omega$ 、 I_F =16mA の 条件での t_{off} 、を読み取ると $\stackrel{.}{=}$ 75 μs です。 さらに図 2.21 の I_F 依存性から I_F =8mA 条件の時を見積ると

 R_L =4.7kΩ、 I_F =8mA では t_{off} =70 μ s となります。





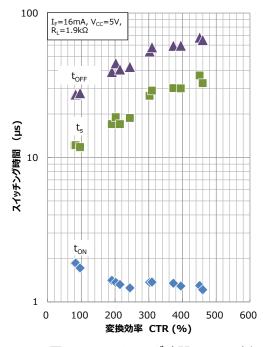
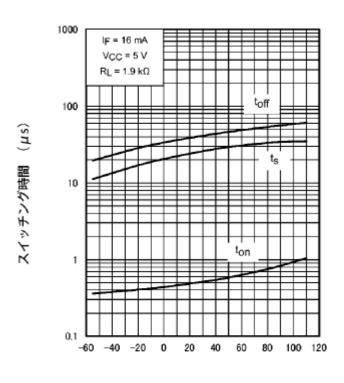


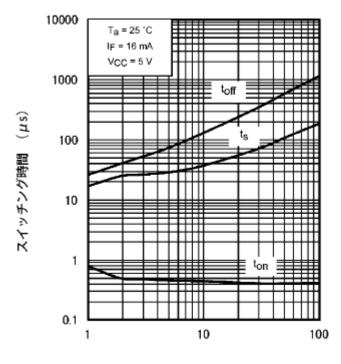
図 2.18 スイッチング時間-CTR の例

スイッチング時間の Ta 依存性(CTR \rightleftharpoons 200%の製品)を図 2.19 に示します。 Ta = 25°C から 70°C へ変化したときの増加率はおよそ 130%ですので、温度変化を考慮すると T= 70 μ s x 1.3 \rightleftharpoons 90 μ s を考えておく必要があります。 また CTR = 100-600%の間でのばらつきを 2 倍と仮定すると最大で T \rightleftharpoons 180 μ s となります。

実際の設計の際には各製品のデータシートや実力を確認の上それらの影響を考慮して設定を行います。今回は 200µs 以下が期待できますがマージンが十分かどうかは良く吟味が必要です。







周囲温度 Ta (°C)

図 2.19 TLP185(SE データシートの抜粋 スイッチング時間 - Ta 特性

図 2.20 TLP185(SE データシートの抜粋 スイッチング時間 - R_L特性

負荷抵抗 R_L (kΩ)

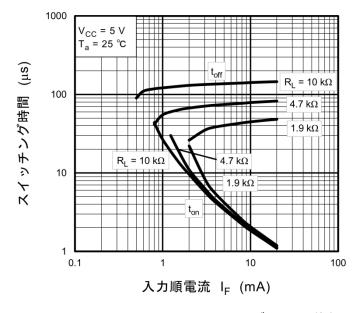


図 2.21 TLP185(SE スイッチング時間-I_F依存性



(2)TLP183 の場合

図 2.23 の R_L 依存性グラフから R_L =10 $k\Omega$ 、 I_F =1.6mA の条件での t_{off} を読み取ると \Rightarrow 90 μ s です。さらに図 2.24 の I_F 依存性から I_F =1mA 条件の時を見積ると

 R_L =10k Ω 、 I_F =1mA でも t_{off} =90 μ s となります。

スイッチング時間の Ta 依存性(CTR \rightleftharpoons 200%の製品)を図 2.22 に示します。 Ta = 25 $^{\circ}$ C から 70 $^{\circ}$ C へ変化したときの増加率はおよそ 130%ですので、温度変化を考慮すると T=90 μ s x 1.3 \rightleftharpoons 120 μ s を考えておく必要があります。 また CTR=100-600%の間でのばらつきを 2 倍と仮定すると最大で T \rightleftharpoons 240 μ s となります。

実際の設計の際には各製品のデータシートや実力を確認の上それらの影響を考慮して設定を行います。今回の試算では 200µs 以下に収まらない可能性が高いと考えられます。何らかの策を講じることを検討します。

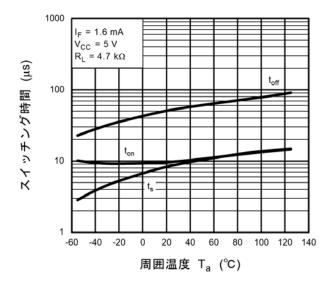


図 2.22 TLP183 データシートの抜粋 スイッチング時間 - Ta 特性

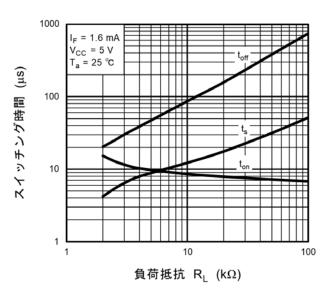


図 2.23 TLP183 データシートの抜粋 スイッチング時間 - R_L特性

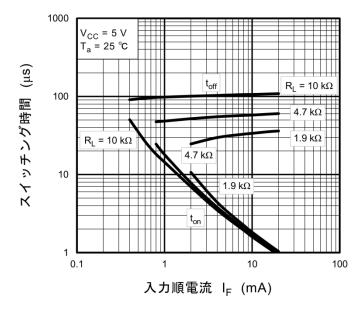


図 2.24 TLP183 スイッチング時間-I_F依存性



そのためには図 2.23 の R_L 依存性グラフから読み取れるように R_L を小さくする方法を取ります。一方「2.3 プルアップ抵抗 R_L の設定」の章の「(1)TLP185 の場合」で述べた I_F との関係を成立させる条件を探し出す必要があります。 その選択肢として

- ① I_F の設定値を $1mA \rightarrow 2mA$ に上げることで R_L を $10k\Omega \rightarrow 4.7k\Omega$ に変更
- ② I_F の設定値は 1mA のままとし、TLP183 の CTR のランク(I_F =0.5mA, V_{CE} =5V)を"GB"ランク(100~600%) \rightarrow "BL"ランク(200~600%)に変更することで R_L を $10k\Omega \rightarrow$ 4.7k Ω に変更

を取り上げることで可能となります。これによって T=50 μ s x 1.3 \rightleftharpoons 65 μ s を想定でき、ばらつきを 2 倍と仮定しても最大で T \rightleftharpoons 130 μ s となり 200 μ s 以下が期待できるようになります。

(3)TLP2301 の場合

TLP2301 は伝搬遅延時間の最大 30µs を保証しています。

表 2.2 TLP2301 t_{pHL}, t_{pLH} 仕様 (データシートから抜粋*)

(Ta=25°C)

項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
伝搬遅延時間 (H/L)	t _{pHL}		図 10.1 参照 V_{CC} = 5 V, I_F = 1 mA, R_L = 10 k Ω	_	8	30	μs
伝搬遅延時間 (L/H)	t _{pLH}		図 10.1 参照 $V_{CC} = 5 \text{ V, I}_F = 1 \text{ mA,}$ $R_L = 10 \text{ k}\Omega$	_	15	30	μ\$

*表中の測定回路図、注記は各製品のデータシートを参照して下さい。

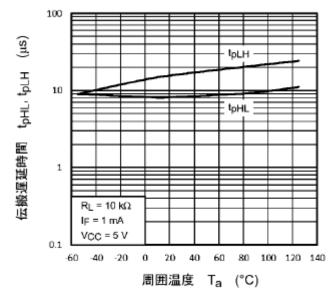


図 2.25 TLP2301 データシートの抜粋

t_{pHL}, t_{pLH} - Ta 特性

 I_F , R_L , V_{CC} の設定は規定条件と同じ 1mA, 10k Ω , 5V ですので Ta 依存性を確認します。Ta=70 $^{\circ}$ C 時に遅延時間は最も遅くなります。

t_{pLH}(@Ta=25°C)=16µs, t_{pLH}(@Ta=70°C)=20µs を読み取り、変化率を計算すると D_{Ta}=20µs / 16µs ≒ 1.25

t_{pHL}(@Ta=25°C)=8µs, t_{pHL}(@Ta=70°C)=9µs を読み取り、変化率を計算すると D_{Ta}=9µs /8µs ≒1.13 従って

 $T = 30 \times 1.25 + 30 \times 1.13 = 72 \mu s \le 100 \mu s$

以上より温度特性を考慮しても T \leq 200 μ s の 5kbps データ伝送は十分可能、また T \leq 100 μ s ですから 10kbps の 信号伝送も実現できると考えられます。



2.5 低 | 駆動製品で性能を最大限引き出す留意点

TLP185 は汎用の性能を有した製品です。確実な ON/OFF 信号伝送動作を得るためには I_F は 10~十数 mA で駆動することが必要になってきます。一方 TLP183 や TLP2301 は 1mA 程度の低 I_F 領域の駆動で十分 ON/OFF 信号伝送動作ができるような能力を有しています。

またスイッチング特性の面では一般的に汎用トランジスタカプラの場合は伝搬遅延時間のばらつきが大きく、飽和条件での最大値の保証はありませんので標準値を基に変換効率や温度特性、プルアップ抵抗による特性変動分を考慮してスイッチング時間を見積る必要があります。一方、TLP2301 は伝搬遅延時間、特にトランジスタのターンオフ時間を高速化し、ばらつきを抑えることで最大値を保証しています。製品の変換効率にかかわらず最大 30µs を保証しているため、トランジスタカプラのように変換効率によるスイッチング時間の変動分を考慮する必要がなく、より容易に遅延時間を設計することができます。

表 2.3(1) 汎用トランジスタカプラ TLP185(SE の遅延時間(Ta=25℃) (データシートから抜粋*)

項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
ターンオン時間	t _{on}		図10.1参照	_	0.5	_	
蓄積時間	ts		$V_{CC} = 5 \text{ V}, I_F = 16 \text{ mA},$ $R_1 = 1.9 \text{ k}\Omega$	_	25	_	μs
ターンオフ時間	t _{off}		11 - 1.5 haz	-	40	_	

表 2.3(2) 20kbps 中速カプラ TLP2301 の遅延時間(Ta=25℃) (データシートから抜粋*)

項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
伝搬遅延時間 (H/L)	t _{pHL}		図 10.1 参照 V_{CC} = 5 V, I_F = 1 mA, R_L = 10 k Ω	_	8	30	μs
伝搬遅延時間 (L/H)	t _{pLH}		図 10.1 参照 $V_{CC} = 5 \text{ V, I}_F = 1 \text{ mA,}$ $R_L = 10 \text{ k}\Omega$		15	30	μs

^{*}表中の測定回路図、注記は各製品のデータシートを参照して下さい。

しかしながら、低 I_F 駆動品の TLP183 や TLP2301 を使用する場合、駆動電流 I_F はやプルアップ抵抗 R_L の選定が不適切だと、製品の性能が十分活かされない動作になる場合があることを留意する必要があります。

前章までで検討してきた内容を並べてみると表 2.4 のようになります。

表 2.4 トランジスタカプラを使ったインタフェース回路の設計例のサマリ

品番	TLP185(SE	TLP183			TLP2301
	I _F =8mA	$I_F=1mA$	$I_F=1mA$	$I_F=2mA$	I _F =1mA
設定	$R_L=4.7k\Omega$	$R_L=10k\Omega$	$R_L=4.7k\Omega$	$R_L=4.7k\Omega$	$R_L=10k\Omega$
	CTR:GB ランク	CTR:GB ランク	CTR:BL ランク	CTR:GB ランク	CTR:GB ランク
パフォーマンス	T≒180µs 程度	T≒240µs 程度	T≒130µs 程度	T≒130µs 程度	T≒75µs 程度

(GB $\exists 20$: $100 \sim 600\%$) BL $\exists 200 \sim 600\%$)

(1)TLP183 の例では前章 2.4 で、

TLP185(SE と同じ R_L 条件の $I_F=2mA$, $R_L=4.7k\Omega$, $V_{CC}=5V$ の場合では $T \doteqdot 130\mu s$ を算出しましたが、もし TLP185(SE での条件 $I_F=8mA$ で使用したとすると図 2.27 から $T \doteqdot 160\mu s$ 程度の予測値になります。 結果 TLP185(SE と同程度のパフォーマンスに見え TLP183 の製品特徴が活きないということになります。



また、表 2.4 からも読み取れるように、TLP183 の低 I_F駆動を活かした条件でも

- $\cdot I_F = 1 \text{mA}$, $R_L = 10 \text{k}\Omega$, $V_{CC} = 5 \text{V}$, CTR:GB ランク の組み合わせ
- \cdot I_F=1mA, R_L=4.7k Ω , V_{CC}=5V, CTR:BL ランク の組み合わせ または

 I_F =2mA, R_L =4.7k Ω , V_{CC} =5V, CTR:GB ランク の組み合わせ

の2つの間ではスイッチング時間のパフォーマンスに大きな違いが出てくることになるので慎重な吟味が必要になります。

(2)TLP2301 の例では前章 2.1~2.4 を通して

 I_F =1mA, R_L =10kΩ, V_{CC} =5V を選定し、T= t_{OFF} + t_{ON} =75 μ s

を算出しました。上の(1)と同様に TLP185(SE での条件 $I_F=8mA$, $R_L=4.7k\Omega$, $V_{CC}=5V$ との間でどのような変化が見られるのかを取り出してみます。次の2つの視点で取り上げることができます。

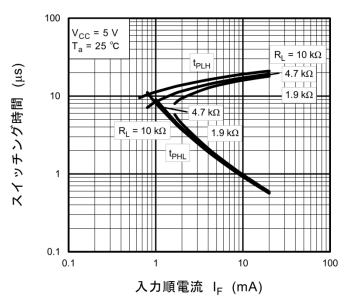
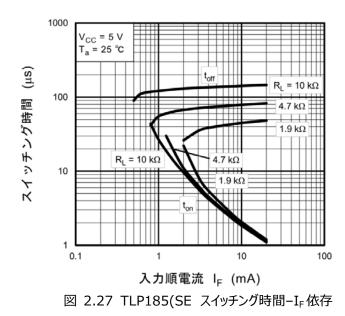


図 2.26 TLP2301 スイッチング時間-I_F依存性



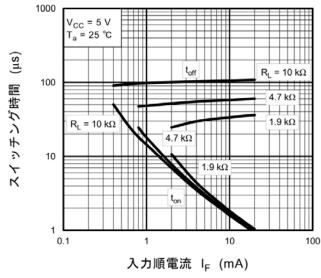


図 2.28 TLP183 スイッチング時間-I_F依存性

©2019



 $①R_L$:10kΩ⇔4.7kΩ

図 2.26~図 2.28 から読み取れるように TLP2301 では TLP185(SE や TLP183 ほどの R_L 依存性は現れません。

②I_F:1mA⇔8mA

図 2.26 から読み取れるように TLP2301 では $T=t_{OFF}(t_{pLH})+t_{ON}(t_{pHL})$ の中の $t_{OFF}(t_{pLH})$ と $t_{ON}(t_{pHL})$ のバランスが I_F が大きくなると大きくずれてきます。低 I_F 領域に当たる $I_F=1$ mA 前後で $t_{OFF}(t_{pLH})$ と $t_{ON}(t_{pHL})$ が同レベルの値になります。 I_F の領域による ON と OFF のバランスの違いを意識する必要があります。

(3)図 2.29 は TLP2301 と TLP185(SE のスイッチング時の波形を比較したものです。 フォトカプラの OFF 時の立ち上がりの早さに違いがあります。

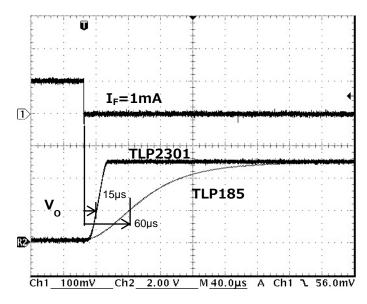


図 2.29 スイッチング時の波形比較 TLP185 と TLP2301

条件: I_{F} =1mA, R_{L} =10k Ω , Ta=25 $^{\circ}$ C. CTR TLP2301= 250%, TLP185=100% @ I_{F} =1mA

t_{pLH} 測定ポイント: I_F=0.5mA, V_O=2V



3. 用語説明

(フォトカプラ共通)

用語		記号	説明
絶 対 最 大 定	格		動作中に瞬時といえども超えてはならない最大値
—————————————————————————————————————	圧	BV _S	入力・出力間の絶縁耐量を定義する電圧
入 出 力 間 浮 遊 容 端子間容量(入力-出力		C _S	入力端子-出力端子間の静電容量
端 子 間 容 端 子 間 容 量 (入 カ	量 側)	C _T C _t	LED アノード端子-カソード端子間の静電容量
直 流 順 電 入 力 順 電	流 流	I _F	連続的に LED 順方向に流し得る電流定格
パ ル ス 順 電 入 カ 順 電 流 (パ ル	流 ス)	I _{FP}	瞬時的に LED 順方向に流し得る電流定格
過 度 パ ル ス 順 電 ピ – ク 過 渡 入 カ 順 ^電	, ,,,,,	I _{FPT}	瞬時的に LED 順方向に流し得る電流定格
直 流 逆 電 入 力 逆 電	圧 圧	V _R	LED 逆方向 (カソード-アノード間)に印加し得る逆電圧定格
逆 電 入 力 逆 で 電	流流	I _R	LED 逆方向 (カソード-アノード間) に流れる漏れ電流
順 電 入 カ 順 電	圧 圧	V _F	規定の順電流値での LED アノード-カソード間電圧
L E D 許 容 損 入 カ 許 容 損	失 失	P _D	LED で許容し得る電力損失定格
全 許 容 損	失	P _T	入力・出力の全回路で許容し得る電力損失定格
	抗	Rs	規定の電圧値での入力端子-出力端子間の抵抗値
接合(部)温	度	Tj	受光素子または LED のジャンクション部で許容し得る温度定格
動 作 温	度	T _{opr}	素子の機能を損なうことなく動作させ得る周囲温度範囲
は ん だ 付 け 温	度	T _{sol}	素子の機能を損なうことなく端子をはんだ付けするための温度定格
保 存 温	度	T _{stg}	素子を動作させない状態で保存し得る周囲温度範囲
沿 面 距	離		絶縁物質に沿った2つの導体間(入力-出力間)の最短距離
空 間 距	離		空気中で 2 つの導体間(入力-出力間)の最短距離
絶 縁 物	厚		2 つの導体間(入力-出力間)に存在する絶縁物の最小厚み



(トランジスタ出力)

				==			=	=14
		用		語			記号	説明
⊐	レ	ク	5) 	電	流	I _C	コレクタに流し得る電流定格
変		換		効		率	I _C /I _F (CTR)	入力 LED 電流 I _F に対する出力電流 I _C の比 : I _C /I _F × 100 (単位%)
暗			電			流	I _{CEO} I _{DARK}	コレクタ-エミッタ間に流れる漏れ電流
⊐	レク	タ	オ	フ	電	流	I _{C (off)}	入力に低電圧を印加したときのコレクタ-エミッタ間に流れる漏れ電流
直	流	電	流	増	幅	率	h _{FE}	受光トランジスタの hFE
ベ	_	ス	거	ć	電	流	I_{PB}	規定の入力電流 I _F で受光トランジスタベース部に発生する光電流
⊐	レ	ク	5	7	損	失	P _C	コレクタで許容し得る電力損失定格
9	_	ン	オ	ン	時	間	t _{ON}	入力オフ → オン時点から、出力波形が 100 (0) %から 10 (90) %まで遷移する のに要する時間
<i>9</i>	_	ン	オ	フ	 時	間	t _{OFF}	入力オン → オフ時点から、出力波形が 0 (100) %から 90 (10) %まで遷移するのに要する時間
蓄		積		時		間	ts	入力オン $ ightarrow$ オフ時点から、出力波形が $0~(100)~\%$ から $10~(90)~\%$ まで遷移する のに要する時間
立	ち	下	が	り	時	間	t _f	出力波形の 90%から 10%まで遷移するのに要する時間
立	ち	上	が	り	時	間	t _r	出力波形の 10%から 90%まで遷移するのに要する時間
コレ	/ クタ・	- I ミ	ッタ	間飲	包和官	10 圧	V _{CE} (sat)	規定の飽和条件におけるコレクタ-エミッタ間の電圧
⊐l	ノクタ	- ベ -	- ス	間降	* 伏 冒	图 圧	V (BR) CBO	エミッタを開放にしたときのコレクタ-ベース間の降伏電圧値
コレ	/ クタ・	- I ミ	ッタ	間降	子 伏 冨	10 圧	V (BR) CEO	(ベースを開放にしたときの)コレクタ-エミッタ間の降伏電圧値
ΙΞ	ミッタ	- ベ -	- スト	間 降	伏冒	图 圧	V (BR) EBO	コレクタを開放にしたときのエミッタ・ベース間の降伏電圧値
ΙΞ	ミッタ -	コレ	クタ	間隆	子伏 [10 圧	V (BR) ECO	(ベースを開放にしたときの)エミッタ-コレクタ間の降伏電圧値
٦	レクタ	タ - 4	ベー	ス	間電	圧	V _{CBO}	コレクタ-ベース間に印加し得る電圧定格
JΙ	レクタ	' - I	Ξ ;	у <i>9</i>	間電	正	V _{CEO}	コレクタ-エミッタ間に印加し得る電圧定格
I	ミック	7 - /	ベ ー	ス	間電	圧	V _{EBO}	エミッターベース間に印加し得る電圧定格
I.	ミッタ	- 그	レ!	フタ	間電	正	V _{ECO}	エミッターコレクタ間に印加し得る電圧定格
端 コ l	子 レ ク タ		間にきい		容 間 容	量	C _{CE}	コレクタ端子-エミッタ端子間の静電容量



変更履歴

バージョン情報	日付	対応頁数	変更内容
Rev. 1.0	2019-05-17	-	初版



製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。 本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器(以下"特定用途"という)に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器(ヘルスケア除く)、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- ◆ 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- ◆ 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び 第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証(機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。)をしておりません。
- 本製品には GaAs(ガリウムヒ素)が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、 粉砕や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいは その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出 管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

東芝デバイス&ストレージ株式会社

https://toshiba.semicon-storage.com/jp/